

## Beschreibung

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung und ein Verfahren zum Reinigen wenigstens einer Prozesskammer zum Beschichten wenigstens eines Substrats, insbesondere aus Glas.

Durch Aufbringen von Funktionsschichten auf eine Glasoberfläche können dem Glas verschiedene Eigenschaften verliehen werden. So lassen sich aus Hohlgläsern oder aus Flachgläsern, durch Aufbringen von Schichten, insbesondere metallische, Polymer- oder Hartstoffschichten, Gläser für optische Anwendungen, Spiegelgläser oder Wärme- und Sonnenschutzgläser erzeugen, beispielsweise für Fensterscheiben, als Fassadenverkleidung oder für Displays.

Das Aufbringen einer Schicht kann auf unterschiedliche Weise aus einer Lösung oder aus der Gasphase erfolgen. Durch die Abscheidung von Beschichtungsmaterialien aus der Gasphase lassen sich insbesondere sehr gleichmäßige und, falls dies gewünscht ist, auch sehr dünne Schichten auf dem Glas erzeugen. Besonders vorteilhaft lassen sich auf diese Weise auch mehrlagige Schichten aus unterschiedliche Materialien erhalten. Zu den Abscheidungsverfahren aus der Gasphase zählen physikalische Abscheidungsverfahren (PVD = Physical Vapour Deposition) wie das Bedampfen oder die Kathodenzerstäubung (Sputtern) und chemische Abscheidungsverfahren (CVD = Chemical Vapour Deposition).

Beim Bedampfen, insbesondere Hochvakuumverdampfen, werden genau berechnete Mengen des jeweiligen verdampfbar Beschichtungsmaterials, insbesondere Metalls, in einer Prozesskammer bei Drücken zwischen  $10^{-8}$  und  $10^{-9}$  bar vollständig verdampft. Dazu wird das Beschichtungsmaterial in einem Tiegel im Hochvakuum erhitzt, beispielsweise durch resistive oder induktive Erwärmung. Das dampfförmige Beschichtungsmaterial schlägt sich dann sehr gleichmäßig auf dem vergleichsweise kalten Substrat, dem Glas, nieder.

Durch Kathodenzerstäubung bzw. Sputtern lassen sich beispielsweise Metallschichten oder Metalloxidschichten auf das Substrat aufbringen. Dazu wird in einem geschlossenen System das Beschichtungsmaterial, insbesondere Metall, in Form einer Platte (Target) als Kathode geschaltet. Ihr gegenüber wird das Substrat, insbesondere Glas, und eine positiv geladene Anode angebracht. Als Rest-

gas befindet sich in einer auf einen Druck von  $10^{-4}$  bis  $10^{-6}$  bar evakuierten Prozesskammer vorzugsweise ein Edelgas, zum Beispiel Argon (für ein reaktives Sputtern kann auch ein Reaktionsgas eingeführt sein). Zwischen Anode und Kathode wird eine Spannung angelegt. Elektronen werden zur Anode hin beschleunigt und ionisieren dabei durch Stoss dazwischen befindliche Argonatome. Die positiv geladenen Argonatome werden im elektrischen Feld zur Kathode hin beschleunigt. Durch den mechanischen Impulsübertrag der Ionen auf das Target kommt es zum Abstäuben der Targetatome, die sich auf dem gegenüberliegenden Substrat, beispielsweise eine Glasscheibe, niederschlagen und einen Film bilden. Bei diesem Vorgang werden neben neutralen Atomen des Targets auch Elektronen freigesetzt. So entsteht zwischen den beiden Elektroden ein stationäres Plasma. Am gebräuchlichsten sind das DC-Sputtern, das HF-Sputtern, das Magnetron-Sputtern, das Gasfluss-Sputtern, das reaktive Sputtern und das Bias-unterstützte Sputtern.

Bei der chemischen Gasphasenabscheidung (CVD) erfolgt normalerweise zunächst eine Reaktion zwischen zwei Edukten im Gasraum, wobei sich das Reaktionsprodukt anschließend auf dem Substrat niederschlägt. Beim CVD-Verfahren wird die Prozesskammer vorzugsweise vor dem Einbringen der gasförmigen Edukte evakuiert, um störende Fremdstoffe zu entfernen, das Verfahren selbst kann bei Normaldruck oder bei gegenüber dem Umgebungsdruck reduziertem Druck ( $10^{-5}$  bis  $10^{-2}$  bar) stattfinden.

Den Abscheidungsverfahren aus der Gasphase ist gemeinsam, dass sehr niedrige Drücke (Vakuum) erzeugt werden. Dadurch wird unter anderem ein störender Einfluss unerwünschter Stoffe in der Gasphase während eines Beschichtungsvorgangs vermindert. Ein Arbeitsvorgang bzw. Beschichtungsvorgang umfasst zumindest das Einstellen der gewünschten Prozessparameter, worunter auch das Evakuieren der Prozesskammer bzw. Beschichtungskammer fallen kann, sowie das Einbringen wenigstens eines zu beschichtenden Substrats in die Beschichtungskammer, den Beschichtungsprozess aus der Gasphase, der vorzugsweise bei Unterdruck bzw. Teilvakuum stattfindet, sowie das Entfernen des Substrats aus der Beschichtungskammer. Das Beschichtungsverfahren kann zudem kontinuierlich oder diskontinuierlich erfolgen. Vor dem Beschichtungsvorgang bzw. vor dem Beschichtungsprozess wird die Beschichtungsanlage evakuiert, um störende Verbindungen wie Wasser, Wasserstoff, Stickstoff, Sauerstoff

oder weitere, beispielsweise in einem vorangehenden Prozess verwendete Verbindungen oder Gase aus der Prozesskammer zu entfernen.

5 Zwischen den einzelnen Chargen einer diskontinuierliche Beschichtungsanlage oder bei Substrat oder Produktwechsel in einer kontinuierlich Beschichtungsanlage sowie für Reinigungs- oder Wartungsarbeiten, kann es vorteilhaft sein, die Beschichtungsanlage zu öffnen. Dabei kann zumindest Umgebungsluft in die Prozesskammer gelangen, durch die wiederum störende Gase, Wasserdampf, Wasser oder weitere Verbindungen in die Prozesskammer eingebracht werden.  
10 Anschließend sind erneut die jeweiligen Prozessbedingungen einzustellen. Hierbei wird die Prozesskammer zunächst über eine vorgegebene Zeitdauer, beispielsweise über eine Absaugpumpe, entleert bzw. evakuiert, um die störenden Fremdstoffe zu entfernen.

15 In der Praxis wurde jedoch beobachtet, dass bei der Evakuierung der Prozesskammer meist nicht alle Fremdstoffe entfernt werden. So können beispielsweise bei der Evakuierung der Prozesskammer an oder in Innenwänden oder Einbauten der Prozesskammer adsorbierte oder kondensierte Stoffe oder gefangene Gase, insbesondere Wasser oder Wasserdampf aber auch verschiedene andere  
20 Stoffe oder Gase, in die Gasphase der Prozesskammer überführt werden, die sich von der Absaugpumpe innerhalb der vorgegebenen Abpumpzeit meist nicht vollständig entfernt lassen. Diese Stoffe können dann die Prozesskammer oder das in diese eingeführte Substrat verunreinigen und somit den anschließenden Beschichtungsprozess negativ beeinflussen. Dadurch wird die Qualität  
25 zumindest der ersten beschichteten Substrate verschlechtert. Diese nicht optimal beschichteten Substrate werden in der Praxis als Ausschuss entsorgt.

Darüber hinaus können sich während des Beschichtungsprozesses auch an den Innenwänden und Einbauten der Prozesskammer feste Bestandteile des Beschichtungsmaterials absetzen, die, wenn sie auf das Substrat fallen, ebenfalls  
30 für eine gewisse Menge an Ausschuss sorgen.

Eine Aufgabe der Erfindung ist es nun, ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Reinigung wenigstens einer Prozesskammer zum Beschichten eines Substrats  
35 bereitzustellen, durch die die vorgenannten Nachteile beim Stand der Technik wenigstens teilweise überwunden oder zumindest vermindert werden.

Diese Aufgabe wird hinsichtlich des Verfahrens mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1 und hinsichtlich der Vorrichtung mit den Merkmalen des Patentanspruchs 21 gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbildungen ergeben sich aus den von Anspruch 1 bzw. Anspruch 21 jeweils abhängigen Ansprüchen.

Bei dem Verfahren gemäß Anspruch 1 zum Reinigen wenigstens einer Prozesskammer zum Beschichten wenigstens eines Substrats, insbesondere aus Glas, wird die wenigstens eine Prozesskammer vor einem Beschichtungsvorgang mit einem konditionierten Spülgas gespült.

Die Vorrichtung gemäß Anspruch 21 ist zum Reinigen wenigstens einer Prozesskammer zum Beschichten wenigstens eines Substrats, insbesondere aus Glas, und insbesondere zur Verwendung in dem Verfahren nach Anspruch 1 oder einem oder mehreren der von Anspruch 1 abhängigen Ansprüche geeignet und bestimmt und umfasst wenigstens eine Spüleinrichtung zur Einleitung eines konditionierten Spülgases in die wenigstens eine Prozesskammer und/oder zur Durchleitung eines konditionierten Spülgases durch die wenigstens eine Prozesskammer vor einem Beschichtungsvorgang.

Das Substrat ist vorzugsweise ein Gegenstand aus Glas, insbesondere aus einem Flachglas oder einem Hohlglas. Durch das Aufbringen von Schichten, insbesondere metallischen Schichten, Polymerschichten oder Hartstoffschichten in einem Beschichtungsvorgang wird dem Glas in der Regel eine bestimmte Eigenschaft oder Funktion verliehen. Der Beschichtungsvorgang umfasst das Einstellen der Prozessparameter, beispielsweise Druck und Temperatur, das Einbringen des Substrats in die Prozesskammer und das Beschichten des Substrats, sowie das Entfernen des beschichteten Substrats aus der Prozesskammer. Der Beschichtungsvorgang findet vorzugsweise bei sehr niedrigen Drücken statt, kann aber auch bei beliebigen anderen Drücken, beispielsweise Umgebungsdruck bzw. Normaldruck, durchgeführt werden. Für die Beschichtung der Substrate werden bevorzugt chemische und physikalische Verfahren zur Abscheidung aus der Gasphase verwendet wie sie aus dem Stand der Technik bekannt sind, zum Beispiel CVD-Verfahren oder PVD-Verfahren wie Bedampfen oder Kathodenzerstäuben (Sputtern).

Die Beschichtung kann in nur einer Prozesskammer erfolgen, es ist aber auch möglich, dass das Substrat mehrere Prozesskammern passiert, wobei jeweils das gleiche Beschichtungsmaterial oder unterschiedliche Beschichtungsmaterialien auf das Substrat aufgebracht werden. Findet die Beschichtung bei sehr niedrigen Druck (Vakuum) statt, so befinden sich am Eingang und Ausgang der Prozesskammern jeweils Druckschleusen, so dass die Prozessbedingungen in den Prozesskammern beim Ein- und Ausbringen eines Substrats unverändert bleiben.

10

Das Spülen der Prozesskammer mit konditioniertem Spülgas findet vor dem Beschichtungsvorgang, also vor dem Einstellen der Prozessparameter und vor dem Einbringen des Substrats statt. Das bedeutet die Prozesskammer wird vorzugsweise bei Umgebungsdruck bzw. Normaldruck gespült, um Verunreinigungen wie Wasser, Wasserdampf oder andere Flüssigkeiten und Gase auszutragen, so dass diese bei einer Evakuierung nicht in die Prozesskammer desorbieren, verdampfen oder austreten können. Das Spülgas kann dazu hinsichtlich der Feuchtigkeit und/oder der Temperatur und/oder des Druckes und/oder der Gaszusammensetzung als Konditioniergröße(n) konditioniert sein und sollte vorzugsweise frei von anderen Verunreinigungen sein. Ferner kann das Spülgas einem der Beschichtung vorhergehenden Prozess oder einer separaten Quelle entstammen. Nachdem das Spülgas die Prozesskammer(n) passiert hat, kann es entweder wieder aufbereitet oder entsorgt werden.

25

Ein der Erfindung zugrundeliegender Gedanke ist also, durch Spülen der Prozesskammer vor dem Start eines Beschichtungsvorgangs bereits möglichst viele Verunreinigungen bzw. Fremdstoffe aus der Prozesskammer zu entfernen, um so einen optimalen Beschichtungsprozess mit verminderter, vorzugsweise überhaupt keiner Ausschussproduktion zu ermöglichen. In den Beschichtungsprozess selbst kann in der Regel nicht eingegriffen werden, um solch eine Beeinträchtigung des Beschichtungsprozesses durch Fremdstoffe zu vermindern, da für das gewünschte Beschichtungsergebnis bzw. die gewünschten Schicht vorgegebene Prozessparameter einzuhalten sind. Durch das Spülen der Prozesskammer vor dem Beschichtungsvorgang kann daher erreicht werden, dass an oder in Innenwänden oder Einbauten der Prozesskammer adsorbierte, kondensierte oder gefangene Verunreinigungen bzw. Fremdstoffe, die, wenn der Be-

35

schichtungsprozess bei sehr niedrigen Drücken stattfindet, durch den Unterdruck in die Gasphase übertreten und sich auf dem Substrat ablagern oder den Beschichtungsprozess auf andere Weise beeinflussen können, bereits vor dem Beschichtungsvorgang mit dem konditionierten Spülgas aus der Anlage geführt werden. Dazu ist beispielsweise ein Konzentrationsgefälle zwischen den Fremdstoffen in der Prozesskammer und im Spülgas vorhanden, so dass die Fremdstoff in das Spülgas mit niedrigerer Konzentration übertreten. Unterstützt werden kann der Reinigungsvorgang bzw. Spülvorgang zum Beispiel auch durch eine Temperaturerhöhung in der Prozesskammer, wodurch zum einen die Aufnahmekapazität des Spülgases erhöht werden kann und zum anderen der Übertritt der Fremdstoffe in die Gasphase erleichtert werden kann.

Mit dem Spülgasstrom lassen sich zudem auch feste Teilchen, zum Beispiel lose auf den Innenwänden oder Einbauten der Prozesskammer abgelagerte Teilchen des Beschichtungsmaterials, wenigstens teilweise ausgetragen, abhängig von den jeweiligen Strömungsbedingungen und der Teilchengröße.

Ein weiterer Vorteil des Verfahrens und der Vorrichtung gemäß der Erfindung ist, dass der Reinigungsvorgang, also das Spülen der Prozesskammer mit Spülgas, ohne Eingriff in den Beschichtungsprozess bzw. in die Beschichtungsanlage und deren Steuerung möglich ist, da der Reinigungsvorgang bzw. Spülvorgang unabhängig vom Beschichtungsverfahren vor dem Start des Beschichtungsvorganges erfolgt und die Einrichtungen und Mittel zur Zuführung des Spülgases in die wenigstens eine Prozesskammer der Beschichtungsanlage und/oder zur Durchleitung des Spülgases durch die wenigstens eine Prozesskammer nicht in die Beschichtungsanlage integriert werden müssen. Für die Zuführung bzw. Zuleitung des Spülgases können je nach Anforderung vorhandene Öffnungen und Schleusen verwendet werden. Die Mittel zur Zu- und Abführung und zur Konditionierung des Spülgases sind von der Beschichtungsanlage unabhängig und auch unabhängig steuer- und regelbar. Die Vorrichtung gemäß der Erfindung lässt sich daher an bestehenden Beschichtungsanlagen einfach nachrüsten.

Mit Hilfe des Verfahrens und der Vorrichtung gemäß der Erfindung lässt sich bei der Beschichtung zudem eine Herabsetzung des Wassergehalts in der Grundsicht, eine Senkung des Rotschleiers (Haze) bei Wärmedämmscheiben,

eine Minimierung von PIN-Holes bei Scheiben mit niedriger Transmission, eine Verbesserung der Silberkristallinität sowie eine Verbesserung der Schichthärten und der Schichtqualität erreichen.

5 In einer besonders vorteilhaften Ausführungsform des Verfahrens gemäß der Erfindung wird das Spülgas hinsichtlich der Feuchtigkeit konditioniert. Es wird im Allgemeinen die relative Feuchtigkeit des Spülgases vor dem Eintreten in die wenigstens eine Prozesskammer auf höchstens 30%, insbesondere höchstens 25%, vorzugsweise höchstens 10% oder in besonderen Fällen sogar höchstens  
10 5%, eingestellt. Besonders zur Aufnahme von in oder an den Innenwänden oder Einbauten der Prozesskammer adsorbiertem, kondensiertem oder gefangenem Wasser oder Wasserdampf ist es vorteilhaft, wenn das Spülgas eine geringe Feuchtigkeit besitzt bzw. vor dem Zuführen in die Prozesskammer getrocknet wird. Die Trocknung kann durch alle geeigneten aus dem Stand der Technik  
15 bekannten Gastrocknungsverfahren erfolgen. Dabei kann die Feuchtigkeit beispielsweise durch Adsorption an einem geeigneten Medium oder durch Abkühlen des Gasstroms und Auskondensieren der Feuchtigkeit reduziert werden. Die Feuchtigkeit des Spülgases, kann jedoch auch durch geeignete Methoden erhöht werden, sollte sich dies als vorteilhaft erweisen.

20 Insbesondere vorteilhaft ist es, wenn das Spülgas vor dem Eintreten in die wenigstens eine Prozesskammer von Fremdstoffen gereinigt wird, insbesondere gefiltert wird. Auf diese Weise wird verhindert, dass das Spülgas weitere Verunreinigungen in die Prozesskammer einschleppt. Zur Reinigung des Spülgases  
25 können alle geeigneten aus dem Stand der Technik bekannten Gasreinigungsverfahren angewandt werden. Beispielsweise kann das Spülgas je nach gewünschtem Reinheitsgrad unter Verwendung entsprechender Filterelemente wie Grobfilter, Feinfilter oder Schwebstofffilter gereinigt werden.

30 Vorteilhaft ist es auch wenn die Temperatur des Spülgases vor dem Eintreten in die wenigstens eine Prozesskammer in einem vorgegebenen Temperaturbereich, vorzugsweise auf wenigstens einen vorgegebenen Temperaturwert, eingestellt wird, insbesondere in einem Temperaturbereich zwischen 20 °C und 90 °C, vorzugsweise in einem Temperaturbereich zwischen 60°C und 80°C. Durch das  
35 erwärmte Spülgas lassen sich auskondensierte oder adsorbierte Verunreinigungen besser in die Gasphase überführen. Je höher die Temperatur des Spülgases

ist, desto mehr Feuchtigkeit kann zudem das Spülgas aufnehmen (für Wasser vgl. Mollier-Diagramm).

Besonders zweckmäßig kann es auch sein, wenn der Druck des Spül gases vor dem Eintreten in die wenigstens eine Prozesskammer auf einen vorgegebenen Druckwert eingestellt wird, vorzugsweise in einem Druckbereich von 0,8 bar bis 1,5 bar. Über den Druck lässt sich dann die Strömungsgeschwindigkeit in der Prozesskammer einstellen. Da das Spül gas in der Regel gegen Umgebungsdruck oder Unterdruck durch die Prozesskammer strömt ist es vorteilhaft, wenn das Spül gas mit einem erhöhten Druck bezüglich des Umgebungsdrucks aus einer Konditioniereinrichtung ausströmt, so dass eine relativ hohe Strömungsgeschwindigkeit und ein großer Volumenstrom durch die Prozesskammer erreicht wird. Weiterhin kann es jedoch auch vorteilhaft sein, das Spül gas mit einem bezüglich des Umgebungsdrucks reduzierten Druck durch die Prozesskammer zu führen bzw. während des Reinigungsvorgangs einen reduzierten Druck in der Prozesskammer zu erzeugen, um den Übergang der Verunreinigungen in die Gasphase zu erleichtern.

Als Spül gas wird bei dem erfindungsgemäßen Verfahren vorzugsweise Luft, insbesondere Umgebungsluft, und/oder ein Inertgas verwendet. Das Spülen mit Luft, vor allem Umgebungsluft wird bevorzugt, da es relativ preiswert ist, große Mengen zur Verfügung stehen und gegebenenfalls bereits konditionierte Luft aus einem Prozessluftkreislauf verwendet werden kann. Inertgas wird vorzugsweise dann zum Spülen verwendet, wenn im Beschichtungsprozess beispielsweise kein Sauerstoff oder sonstige störende Gase vorliegen sollten. Die Verwendung von Inertgas ist jedoch in der Regel kostenintensiver als die von Luft, vor allem von Umgebungsluft. Darüber hinaus ist es möglich weitere Gase oder Gasgemische als Spül gas einzusetzen, die vorzugsweise einen oder mehrere Bestandteile der Umgebungsluft in beliebiger, geeigneter Konzentration aufweisen.

Bei dem Verfahren gemäß der Erfindung wird die wenigstens eine Prozesskammer in einer vorteilhaften Ausführungsform während eines Reinigungsvorgangs bzw. Spülvorgangs von dem konditionierten Spül gas durchströmt, vorzugsweise kontinuierlich. Es kann aber auch vorteilhaft sein, wenn wenigstens ein Reinigungsschritt mit Fluten der Prozesskammer mit konditioniertem Spül-



gas und anschließendem Abführen des Spülgases durchgeführt wird, der auch in Kombination mit der vorgenannten Ausführungsform des Durchströmens erfolgen kann, beispielsweise anschließendes durchströmen der Prozesskammer. Dadurch lässt sich erreichen, dass die Verunreinigungen in das in der Prozess-

5 kammer befindliche konditionierte Spülgas übertreten und mit dem Spülgas abgeführt werden. Bei dem Reinigungsschritt aus Fluten und Abführen kann beispielsweise beim Abpumpen des Spülgases auf einfache Weise auch ein Unterdruck erzeugt werden, der den Übergang von Verunreinigungen in die Gasphase erleichtert. Besonders vorteilhaft kann es auch sein, wenn das Spülgas

10 direkt nach einem Beschichtungsvorgang in die Prozesskammer strömt, wodurch dann, bei einer Beschichtung im Vakuum, der Druck in der Prozesskammer nach Beenden des Beschichtungsvorgangs durch das Spülgas erhöht wird. Auf diese Weise kann abhängig von dem jeweiligen Beschichtungsvorgang das Eintragen von Verunreinigungen in die Prozesskammer bei Substrat oder Pro-

15 duktwechsel vermindert werden.

Findet die Beschichtung bei sehr niedrigem Druck (Vakuum) statt, so befinden sich normalerweise am Eingang und/oder am Ausgang der Prozesskammern jeweils Druckschleusen, durch die das wenigstens eine Substrat in die Prozess-

20 kammer ein- bzw. aus der Prozesskammer ausgeführt wird. Die Druckschleusen verhindern, dass sich die Prozessbedingungen in den Prozesskammern, insbesondere der Druck, beim Ein- und Ausbringen eines Substrats verändern. Sind mehrere Prozesskammern hintereinander geschaltet, so befindet sich zwischen diesen Prozesskammern in der Regel ebenfalls wenigstens eine Druckschleuse.

25 Das ist vor allem dann notwendig, wenn in den verschiedenen Prozesskammern einer Beschichtungsvorrichtung verschiedene Drücke herrschen, was sehr häufig der Fall ist. Durch die Druckschleusen wird dann verhindert, dass ein Gasaustausch zwischen den Prozesskammern stattfindet.

Die Druckschleusen können so ausgeführt sein, dass das Substrat bei dem jeweiligen Umgebungsdruck in die Druckschleuse geführt wird, also insbesondere

30 beim Einführen in eine erste Prozesskammer in etwa bei Normaldruck und beim Einführen in eine weitere Prozesskammer, bei dem jeweilige Druck in der vorhergehenden Prozesskammer. Anschließend wird die Druckschleuse verschlossen und durch Evakuieren oder durch Zugabe von Gas auf den jeweiligen

35 Druck der folgenden Prozesskammer eingestellt. Die Druckkammer wird dann zu der folgende Prozesskammer hin geöffnet, das Substrat in die Prozesskam-

mer eingeführt und die Druckschleuse wieder verschlossen und durch Evakuieren oder durch Zugabe von Gas erneut auf den Anfangsdruck zur Aufnahme eines Substrats gebracht. Beim Stand der Technik wird der jeweilige Druckausgleich in der Regel durch Zugabe von Umgebungsluft durchgeführt. Dabei können jedoch über die Umgebungsluft Fremdstoffe in die Druckschleuse gelangen, die im Verlaufe des Verfahrens in die Anlage verschleppt werden und den Beschichtungsprozess beeinflussen können.

In einer besonders bevorzugten Weiterbildung des Verfahrens oder alternativen, in dem im fakultativ unabhängigen Anspruch 8 beanspruchten Verfahren, wird deshalb während des Reinigungsvorgangs eine an einem Eingang und/oder an einem Ausgang der wenigstens einen Prozesskammer angeordnete Druckschleuse von dem konditionierten Spülgas gespült, vorzugsweise kontinuierlich durchströmt. Auf diese Weise können auch in der Druckschleuse Verunreinigungen entfernt werden, die beim Evakuieren der Druckschleuse in die Gasphase übertreten und beispielsweise das Substrat verunreinigen können.

Insbesondere vorteilhaft ist es, wenn zudem für einen Druckausgleich in der Druckschleuse konditioniertes Spülgas in die Druckschleuse eingeströmt wird und/oder wenn die Druckschleuse, bevor das wenigstens eine Substrat in die Druckschleuse gelangt und/oder während sich das wenigstens eine Substrat in der Druckschleuse befindet, mit konditioniertem Spülgas gespült wird.

Dadurch kann zum einen verhindert werden, dass Fremdstoffe von außen in die Druckschleuse eindringen, und zum anderen können bereits in der Druckschleuse befindliche Fremdstoffe oder durch das Substrat eingetragene Fremdstoffe entfernt werden. Dabei ist es beispielsweise denkbar, dass zunächst der Druckausgleich in der Druckkammer mit Spülgas erfolgt, das Spülgas die Druckschleuse darüber hinaus eine kurze Zeit durchströmt, um zum Beispiel Fremdstoffe aus der Gasphase oder von einem bereits eingebrachten Substrat zu entfernen und die Druckkammer anschließend evakuiert wird. Auf diese Weise kann der Beschichtungsvorgang unter nahezu vollständigem Ausschluss von Umgebungsluft durchgeführt werden. Das aus der Druckschleuse abgeführte Spülgas kann entweder in die Umgebung abgeführt oder dem Spülgaskreislauf zugeführt und erneut konditioniert werden.

Besonders zweckmäßig kann es sein, wenn das Spülgas aus verschiedenen Gasströmen gemischt wird. Dabei kann zum Beispiel ein Gasstrom aus einem der Beschichtung vorhergehenden Prozess mit einem Spülgasstrom aus konditionierter Umgebungsluft oder konditioniertem Gas, vorzugsweise Inertgas, gemischt werden, um auf diese Weise die Kosten für den Reinigungsvorgang zu reduzieren.

Besonders vorteilhaft ist es auch, wenn das Spülgas in einem Kreislauf geführt wird. Dabei wird das aus der wenigstens einen Prozesskammer austretende Spülgas hinsichtlich der Feuchtigkeit und/oder der Beladung mit Fremdstoffen und/oder der Temperatur und/oder des Drucks und/oder der Gaszusammensetzung erneut konditioniert und erneut der wenigstens einen Prozesskammer oder auch einem anderen von der Beschichtung unabhängigen Prozess zugeführt.

Vor dem Beschichtungsvorgang wird das wenigstens eine Substrat in der Regel in einem dem Beschichtungsvorgang vorgeschalteten Substratbehandlungsvorgang vorbehandelt, insbesondere in einem Substratwaschvorgang gereinigt, vorzugsweise mit Wasser oder einer anderen geeigneten Flüssigkeit, und einem anschließenden Substrattrocknungsvorgang getrocknet. Insbesondere vorteilhaft ist es dann, wenn wenigstens ein Teil eines konditionierten Trocknungsgases zum Trocknen des wenigstens eines Substrats in dem Substrattrocknungsvorgang und/oder wenigstens ein Teil eines aus dem Substrattrocknungsvorgang ausgegebenen Trocknungsgases zumindest zu einem Teil als Spülgas verwendet wird.

In einer besonders vorteilhaften Ausführungsform wird zudem die wenigstens eine Prozesskammer vor und/oder während des Reinigungsvorgangs zumindest teilweise beheizt, insbesondere wenigstens ein Teil wenigstens einer Prozesskammerwand. Dazu wird die Wärme vorzugsweise von außen zugeführt über eine außerhalb der Prozesskammer angeordnete Heizeinrichtung. Die wenigstens eine Prozesskammer wird dann zum Beispiels induktiv oder durch Strahlung oder durch Wärmeleitung zumindest teilweise auf eine Temperatur, die im Allgemeinen zwischen 20°C und 60 °C, insbesondere zwischen 40 °C und 60 °C liegt, geheizt. Die Prozesskammer bzw. die Prozesskammerwand kann auch auf höhere Temperaturen beheizt werden, wenn die zur Fertigung der Prozess-

kammer, insbesondere für an der Prozesskammerwand angeordnete Einbauten und Dichtungen, verwendeten Werkstoffe dies erlauben. Die Beheizung der Prozesskammer kann kontinuierlich vor und/oder während des gesamten Reinigungsvorgangs erfolgen oder lediglich für bestimmte Zeitintervalle zur zeit-  
5 weisen Unterstützung eines Reinigungsvorgangs.

Während des Beschichtungsprozesses wird in der Regel nicht nur auf dem Substrat, sondern auch an den Innenwänden und/oder Einbauten der Prozesskammer Beschichtungsmaterial abgeschieden. Werden nacheinander mehrere Substrate beschichtet, so können sich diese Ablagerungen an den Wänden oder  
10 Einbauten ansammeln bzw. aufsummieren bis sich sogenannte Depots bilden. In diesem Fall besteht die Gefahr, dass sich bereits bei leichten Erschütterungen oder auf Grund der Schwerkraft von den Depots Teile lösen und das Substrat bzw. das Produkt verunreinigen. Diese Produkte werden dann in der Praxis als Ausschuss entsorgt.  
15

In einer besonders bevorzugten Weiterbildung des Verfahrens und der Vorrichtung gemäß der Erfindung gibt wenigstens ein Impulsgebereinrichtung vor und/oder während einem Beschichtungsvorgang wenigstens einen mechanischen Impuls auf eine Prozesskammerwand, insbesondere eine Außenwand, der  
20 wenigstens einen Prozesskammer. Dadurch lässt sich ein gezielter Depotabschlag, also ein Abklopfen von an den Innenwänden und Einbauten der Prozesskammer abgelagerten bzw. abgeschiedenen Beschichtungsmaterialteilchen oder -depots, erzielen.

25 Diese Merkmale könnten auch in nebengeordneten Ansprüchen unabhängig beansprucht werden, beispielweise in der folgenden Form: Verfahren zum Reinigen wenigstens einer Prozesskammer zum Beschichten wenigstens eines Substrats, insbesondere aus Glas, bei dem wenigstens eine Impulsgebereinrichtung  
30 vor und/oder während einem Beschichtungsvorgang wenigstens einen mechanischen Impuls auf eine Prozesskammerwand, insbesondere eine Außenwand, der wenigstens einen Prozesskammer gibt, oder Vorrichtung zum Reinigen wenigstens einer Prozesskammer zum Beschichten wenigstens eines Substrats, insbesondere aus Glas, die eine Impulsgebereinrichtung zum Erzeugen eines Impulses auf einer Prozesskammerwand, insbesondere einer Außenwand, der wenigstens einen Prozesskammer umfasst.  
35

Durch das Vorsehen des mechanischen Impulsgebers können diese Depots in regelmäßigen Abständen oder nach Bedarf abgeschlagen werden, bevorzugt zu einem Zeitpunkt bei dem sich kein Substrat in der Prozesskammer befindet, also vor einem Beschichtungsvorgang oder zwischen den Beschichtungsprozessen mehrerer Substrate.

Als mechanische Impulsgebereinrichtung werden vorzugsweise wenigstens ein Hammer und/oder wenigstens eine Druckluftdüse und/oder wenigstens eine Vibrationseinheit und/oder wenigstens ein Ultraschallgeber verwendet. Darüber hinaus kann die wenigstens eine Impulsgebereinrichtung der erfindungsgemäßen Vorrichtung wenigstens eine Steuereinheit umfassen. Der mechanische Impuls wird vorzugsweise in Abhängigkeit wenigstens einer Prozessgröße automatisch ausgelöst. Besonders vorteilhaft ist es, wenn zudem die Stärke des mechanischen Impulses in Abhängigkeit eines Verschmutzungsgrads eingestellt werden kann. In diesem Fall sind geeignete Sensoren in der Prozesskammer vorzusehen. Eine Prozessgröße, die den mechanischen Impuls bzw. das Abschlagen auslöst ist vorzugsweise eine Größe, die anzeigt, dass sich zum jeweiligen Zeitpunkt kein Substrat in der Prozesskammer befindet. Ohne in die Beschichtungsanlage eingreifen zu müssen, könnte dies beispielsweise eine Transportgeschwindigkeit der Substrate in der Beschichtungsanlage oder eine Temperatur oder ein Druck in der Prozesskammer sein. Die Steuereinheit kann dazu dienen den Zeitpunkt zu dem der Impuls ausgelöst wird, die Stärke des Impulses sowie die Zeitdauer über die mechanische Impulse gegeben werden zu steuern und zu regeln. Dazu ist es vorteilhaft, wenn Mittel zur Bestimmung von Prozessgrößen, insbesondere zur Erkennung eines Verschmutzungsgrades in der Prozesskammer vorgesehen sind. Das können beispielsweise in die Prozesskammer eingebrachte optische Sensoren sein. Andere Prozessgrößen wie die Transportgeschwindigkeit der Substrate oder die Temperatur oder der Druck in der Prozesskammer können eventuell auch der Steuereinrichtung der Beschichtungsanlage entnommen werden, wenn sich die Steuereinheit der Impulsgebereinrichtung in einer vorteilhaften Ausführungsform an diese koppeln lässt.

Darüber hinaus kann es auch möglich sein, dass wenigstens ein Teil des aus der wenigstens einen Prozesskammer austretenden Spülgases zur Erzeugung des mechanischen Impulses verwendet wird, zum Beispiel zur Erzeugung eines Im-

pulses durch Ausströmen aus einer Druckluftdüse oder durch Betätigen eines Drucklufthammers.

Bei der Vorrichtung gemäß Anspruch 21 umfasst die wenigstens eine Spüleinrichtung zur Einleitung eines konditionierten Spülgases in die wenigstens eine Prozesskammer und/oder zur Durchleitung eines konditionierten Spülgases durch die wenigstens eine Prozesskammer vorzugsweise wenigstens eine Spülgaszuleitung und wenigstens eine Spülgasfördereinheit, insbesondere eine Pumpe und/oder einen Ventilator, die in einer Strömungsrichtung vor und/oder nach der wenigstens einen Prozesskammer angeordnet sind. Als Strömungsrichtung wird die Richtung bezeichnet, in der das Spülgas die Prozesskammern der Beschichtungsanlage durchströmt.

In einer besonders vorteilhaften Ausführungsform der Vorrichtung gemäß der Erfindung ist wenigstens eine Konditioniereinrichtung zur Konditionierung des Spülgases vor dem Eintreten in die Prozesskammer vorgesehen. Dabei kann vorzugsweise wenigstens eine Konditioniereinrichtung zur Einstellung einer Feuchtigkeit des Spülgases vorgesehen sein, insbesondere eine Adsorptionseinheit oder eine Kühleinheit, vorzugsweise eine Absorptionskältemaschine, und/oder wenigstens eine Konditioniereinrichtung zur Einstellung einer Temperatur des Spülgases vorgesehen sein, insbesondere eine Heizeinrichtung, und/oder wenigstens eine Konditioniereinrichtung zur Einstellung eines Druckes des Spülgases vorgesehen sein, insbesondere ein Verdichter, und/oder wenigstens eine Konditioniereinrichtung zur Abscheidung von Fremdstoffen aus dem Spülgas vorgesehen sein, insbesondere eine Filtereinheit. Wie vorangehend beschrieben, können hierfür alle geeigneten und aus dem Stand der Technik bekannten Einrichtungen verwendet werden. Es können auch mehrere Eigenschaften oder Konditioniergrößen des Spülgases in einer kombinierten Konditioniereinrichtung eingestellt werden.

Sind am Eingang und/oder am Ausgang der wenigstens einen Prozesskammer Druckschleusen vorgesehen, so ist es insbesondere vorteilhaft, wenn die Vorrichtung in einer vorteilhaften Weiterbildung oder alternativ, die im fakultativ unabhängigen Anspruch 25 beanspruchte Vorrichtung, wenigstens eine Zuführeinrichtung zur Einleitung des konditionierten Spülgases in wenigstens eine an einem Eingang der Prozesskammer und/oder an einem Ausgang der Prozess-

kammer angeordnete Druckschleuse und/oder zur Durchleitung des konditionierten Spülgases durch die wenigstens eine Druckschleuse und/oder wenigstens eine Abführeinrichtung für das Spülgas aus der wenigstens einen Druckschleuse umfasst. Über die wenigstens eine Zuführeinrichtung, die beispielsweise  
5 wenigstens eine Zuführleitung und wenigstens eine Zuführeinheit wie einen Ventilator und/oder eine Pumpe umfassen kann, kann dann ein Druckausgleich in der Druckschleuse und/oder ein Spülen der Druckschleuse mit konditioniertem Spülgas erfolgen. Das mittels der wenigstens einen Abführeinrichtung, die beispielsweise wenigstens eine Abführleitung und wenigstens eine Abführeinheit  
10 wie einen Ventilator und/oder eine Pumpe umfassen kann, aus der Druckschleuse abgeführte Spülgas kann erneut der wenigstens einen Konditioniereinrichtung zugeführt werden.

Darüber hinaus umfasst die Vorrichtung vorzugsweise wenigstens eine Heizeinrichtung zum Beheizen wenigstens eines Teils wenigstens einer Prozesskammer  
15 vor und/oder während eines Reinigungsvorganges, die vorzugsweise außerhalb der Prozesskammer angeordnet ist. Die Heizeinrichtung beheizt die Prozesskammer insbesondere induktiv, durch Strahlung oder durch Wärmeleitung.

20 Vor dem Beschichtungsvorgang ist das Substrat in einer Substratbehandlungsvorrichtung zu behandeln, so dass ein optimales Beschichtungsergebnis erzielt werden kann. Dazu ist beispielsweise das Substrat bzw. die Substratoberfläche in einer Substratwaschvorrichtung zu reinigen und anschließend in einer Substrattrocknungsvorrichtung zu trocknen. Für das Substrattrocknen wird beispielsweise ebenfalls ein konditioniertes Gas, vorzugsweise Luft, insbesondere  
25 Umgebungsluft benötigt.

In einer besonders vorteilhaften Ausführungsform der erfindungsgemäßen Vorrichtung entspricht die wenigstens eine Konditioniereinrichtung wenigstens  
30 einer Konditioniereinrichtung einer der wenigstens einen Prozesskammer vorgeschalteten Substratbehandlungsvorrichtung, insbesondere einer Substratwaschvorrichtung mit sich anschließender Substrattrocknungsvorrichtung. Dadurch kann bzw. können sowohl der Energieverbrauch als auch die Kosten reduziert werden.

Insbesondere vorteilhaft ist es, wenn wenigstens ein Mittel vorgesehen ist zur Einleitung wenigstens eines Teils eines aus der Substrattrocknungsvorrichtung austretenden Trocknungsgases und/oder wenigstens eines Teils eines in der wenigstens einen Konditioniereinrichtung der Substrattrocknungsvorrichtung aufbereiteten Trocknungsgases in die Prozesskammer. Das bedeutet, es kann  
5 entweder konditioniertes Gas mit Abgas aus der Substrattrocknungsvorrichtung gemischt werden, so dass ein Spülgas mit noch ausreichend niedrigem Feuchtigkeitsgehalt für die Spülzwecke erhalten wird oder es wird einfach ein Teil des für die Substrattrocknung aufbereiteten Trocknungsgases abgezweigt und als  
10 Spülgas in die wenigstens eine Prozesskammer der Beschichtungsanlage geleitet. Werden das aus der Substrattrocknungsvorrichtung abgeführte Trocknungsgas und das aus der wenigstens einen Prozesskammer abgeführte Spülgas wieder zusammengeführt und zur Aufbereitung erneut der wenigstens einen gemeinsamen Konditioniereinrichtung zugeführt, kann ein sehr wirtschaftlicher Kreis-  
15 lauf erzielt werden.

Bei dem Verfahren gemäß Anspruch 32 zum Beschichten wenigstens eines Substrats, insbesondere aus Glas, in einer Prozesskammer, wird die Prozesskammer vor einem Beschichtungsvorgang gereinigt nach einem Verfahren nach einem  
20 oder mehreren der Ansprüche 1 bis 20 und/oder unter Verwendung einer Vorrichtung nach einem oder mehreren der Ansprüche 21 bis 31. Besonders vorteilhaft ist es, wenn weiterhin nach einem Reinigungsvorgang der Druck in der Prozesskammer gegenüber dem Umgebungsdruck reduziert wird, vorzugsweise auf  $10^{-7}$  bar bis  $10^{-3}$  bar und anschließend ein Beschichtungsprozess gestartet  
25 wird, insbesondere ein Beschichtungsprozess aus der Gasphase, vorzugsweise ein PVD- oder ein CVD-Prozess.

Die Vorrichtung gemäß Anspruch 34 zum Beschichten wenigstens eines Substrats, insbesondere aus Glas, in einer Prozesskammer, insbesondere zum  
30 Durchführen des Verfahren nach Anspruch 32 oder Anspruch 33, umfasst eine separate Vorrichtung zur Reinigung der Prozesskammer vor einem Beschichtungsvorgang durch Spülen mit einem konditionierten Spülgas, insbesondere eine Vorrichtung nach einem oder mehreren der Ansprüche 21 bis 31.

35 Die Erfindung wird im Folgenden anhand von Ausführungsbeispielen und unter Bezugnahme auf die beiliegenden Zeichnungen weiter erläutert.



Es zeigen jeweils in schematischer Darstellung:

- 5        FIG 1    eine Glaswasch- und Gastrocknungsvorrichtung mit anschließender  
         Beschichtungsvorrichtung nach dem Stand der Technik,
- 10       FIG 2    ein Verfahrensfleißbild einer vorteilhafte Ausführungsform des Verfah-  
         rens gemäß der Erfindung für eine Beschichtungsvorrichtung nach FIG  
         1,
- 15       FIG 3    ein Verfahrensfleißbild einer weiteren vorteilhafte Ausführungsform  
         des Verfahrens gemäß der Erfindung für eine Beschichtungsvorrich-  
         tung nach FIG 1,
- 20       FIG 4    eine vorteilhafte Ausführungsform einer mechanischen Impulsge-  
         bereinrichtung einer erfindungsgemäßen Vorrichtung.

Einander entsprechende Teile und Größen sind in den FIG 1 bis 4 mit densel-  
ben Bezugszeichen versehen.

- 20       FIG 1 zeigt eine Glaswaschvorrichtung 22 eine Glastrocknungsvorrichtung 1  
         und eine Beschichtungsvorrichtung 2, wie sie in einem Glasverarbeitungspro-  
         zess nach dem Stand der Technik eingesetzt werden können. In der Glaswasch-  
         vorrichtung 22 werden vorab produzierte Glassubstrate 3 gewaschen, vorzugs-  
25       weise mit Wasser oder einer anderen geeigneten Flüssigkeit, und anschließend  
         in der Glastrocknungsvorrichtung 1 getrocknet, so dass sie möglichst wenig  
         Feuchtigkeit in die Beschichtungsvorrichtung 2, im vorliegenden Fall eine Ma-  
         gnetron-Beschichtungsanlage, einbringen, die den Beschichtungsvorgang nega-  
         tiv beeinflussen kann. Die Glassubstrate 3 werden auf einem Transportband 4  
30       durch eine Trocknungskammer 6 der Glastrocknungsvorrichtung 1 transportiert  
         und mit konditioniertem Trocknungsgas 5 beaufschlagt. Das konditionierte  
         Trocknungsgas 5 wird an mehreren Stellen in die Trocknungskammer 6 einge-  
         blasen und überströmt die Glassubstrate 3, wobei die Feuchtigkeit von der O-  
35       berfläche der Glassubstrate 3 vom konditionierten Trocknungsgas 5 aufge-  
         nommen wird. Das mit der Feuchtigkeit beladene Trocknungsgas wird dann aus  
         der Trocknungskammer 6 abgeführt.

Die getrockneten Glassubstrate 3 gelangen anschließend in die Beschichtungsvorrichtung 2, in der sie mehrere Prozesskammern 7 passieren. In den Prozesskammern 7 werden im Magnetron-Sputterverfahren eine oder mehrere Schichten eines oder mehrerer Stoffe auf das Glassubstrat 3 aufgebracht. Der Sputter-Prozess erfolgt vorzugsweise bei einem Unterdruck von bis zu  $10^{-6}$  bar. Damit der Unterdruck in den einzelnen Prozesskammern 7 beim Durchführen der Glassubstrate 3 aufrecht erhalten werden kann, sind zumindest zwischen der Glastrocknungsvorrichtung 1 und einer Prozesskammer 7 sowie zwischen den einzelnen Prozesskammern 7 und nach der letzten Prozesskammer 7 Druckschleusen (hier nicht dargestellt) vorgesehen, durch die die Glassubstrate 3 geführt werden und in denen ein Druckausgleich stattfindet.

Das Magnetronsputtern ist eine Variante des DC- oder HF-Sputterns, bei welchem dem elektrischen Feld der Glimmentladung ein transversales Magnetfeld überlagert wird. Dazu wird meist hinter dem als Kathode wirkenden Target eine Anordnung aus Permanentmagneten installiert, dessen Magnetfeld durch das Target hindurch in den Plasmaraum reicht. Dies führt dazu, dass das Plasma vor dem Target in einer Art magnetischer Flasche eingeschlossen wird und die Elektronen auf Kreis- bzw. Spiralbahnen vor dem Target gezwungen werden. Dies bewirkt eine erhebliche Erhöhung des Ionisationsgrades des Plasmas und damit eine Steigerung der Zerstäubungs- und Beschichtungsrate. Des Weiteren reduziert sich der Beschuss des Substrates mit Elektronen, wodurch die thermische Belastung des Substrates sinkt. Häufig angewandte Varianten des Magnetron-Sputterns sind das reaktive Magnetron-Sputtern und das bias-unterstützte Magnetron-Sputtern (vgl. Internetauftritt des INO - Informationssystem für die wirkungsvolle Nutzung der Oberflächentechnik, [www.schichttechnik.net](http://www.schichttechnik.net)) Durch das Magnetron-Sputtern lassen sich insbesondere verschiedene Metalle, (z.B. Silber), und Metalloxide (z. B. Zinkoxid) abscheiden, die in geeigneter Zusammensetzung bzw. Schichtstruktur insbesondere als Sonnenschutz- und Wärmedämmschichten dienen.

Wird die Prozesskammer 7 evakuiert, so können an oder in den Innenwänden oder Einbauten der Prozesskammern 7 adsorbierte, kondensierte oder gefangene Stoffe, insbesondere Wasser, in die Gasphase übertreten, die den Beschichtungsprozess stören können, so dass beim Beschichtungsprozess wenigstens

jeweils die ersten beschichteten Glassubstrate 3 Ausschuss sind und entsorgt werden müssen.

5 Wird die Beschichtungsvorrichtung 2 vor dem Beschichtungsvorgang mit dem Verfahren gemäß der Erfindung gereinigt, so kann die Ausschussproduktion verringert oder gar gänzlich vermieden werden.

FIG 2 zeigt in einem Verfahrensfließbild eine vorteilhafte Ausführungsform des Verfahrens gemäß der Erfindung. Die Abbildung zeigt schematisch die Be-  
10 schichtungsvorrichtung 2 die in ihrem Innern wenigstens eine Prozesskammer 7 umfasst (in FIG 2 nicht dargestellt). In einem ersten Schritt wird Umgebungsluft 8 angesaugt und in einem Filter 9 von Fremdstoffen 10 gereinigt. Die Fremdstoffe 10 werden in regelmäßigen Zeitabständen oder kontinuierlich aus dem Filter 9 abgeführt.

15 Die gereinigte Umgebungsluft gelangt in einem weiteren Verfahrensschritt in eine Konditioniereinrichtung zur Einstellung des Feuchtigkeitsgehalts, in diesem Fall eine Kältemaschine 11, die als Absorptionskältemaschine oder als Kompressionskältemaschine ausgeführt sein kann, wie sie aus dem Stand der  
20 Technik bekannt sind. Dort wird die Umgebungsluft auf eine vorbestimmte Temperatur abgekühlt, wobei Wasser auskondensiert. Das Kondensat 12 wird kontinuierlich abgeführt.

Die so getrocknete Umgebungsluft 8 wird anschließend in einer Heizeinrichtung  
25 wieder erwärmt, vorzugsweise auf eine Temperatur zwischen 60 °C und 80°C, um den Verdampfungs- und/oder Desorptionsprozess in der Beschichtungsvorrichtung 2 zu beschleunigen. Die warme und trockene Umgebungsluft 8 weist nun eine relative Feuchtigkeit von vorzugsweise  $\leq 25\%$  auf, und kann eine relativ große Menge Wasser aufnehmen bis zu ihrer Sättigung.

30 In einem Verdichter 14, wird die Umgebungsluft 8 auf einen vorgegeben Druck verdichtet und in die Beschichtungsvorrichtung 2 geblasen. Auf diese Weise lässt sich auch die Strömungsgeschwindigkeit des konditionierten Spülgases 15 einstellen. Ein Ventilator 17, der auf der Austrittsseite der Beschichtungsvorrichtung 2 das beladene Spülgas 16 ansaugt, kann das Durchströmen der Pro-  
35 zesskammern 7 zudem unterstützen.

Mit dem konditionierten Spülgas 15 werden in der Beschichtungsvorrichtung 2 sowohl die wenigstens eine Prozesskammer 7 als auch die Druckschleusen vor und nach sowie zwischen einzelnen Prozesskammern gespült, um Verunreinigungen zu entfernen. Das beladene Spülgas 16 wird dann im einfachsten Fall  
5 vollständig an die Umgebung abgegeben.

Es ist aber auch möglich einen Teil oder den gesamten Volumenstrom des beladenen Spülgases 16 über eine Spülgasrückführung 18 erneut den Konditioniereinrichtungen 9, 11, 13, 14 zuzuführen. Dabei kann auch Umgebungsluft 8 dem beladenen Spülgas 16 beigemischt werden.  
10

Während des Beschichtungsprozesses in der Beschichtungsvorrichtung 2 wird das konditionierte Spülgas 15 weiterhin in die Druckschleusen geführt, vorzugsweise für den Druckausgleich in den Druckschleusen und/oder zum Spülen der Druckschleusen und des eventuell darin befindlichen Glassubstrats 3.  
15

In FIG 3 ist eine weitere vorteilhafte Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens dargestellt. Die Abbildung zeigt ebenfalls schematisch die Beschichtungsvorrichtung 2 die in ihrem Innern wenigstens eine Prozesskammer 7 (nicht dargestellt) umfasst. Wie mit Bezug auf FIG 2 beschrieben wird Umgebungsluft 8 in den Konditioniereinrichtungen 9 (Filter), 11 (Kältemaschine), 13 (Heizeinrichtung), 14 (Verdichter) entsprechend konditioniert.  
20

Die Konditioniereinrichtungen 9, 11, 13, 14 sind in der in FIG 3 dargestellten Ausführungsform für die Aufbereitung von Spülgas für die Beschichtungsvorrichtung 2 und Trocknungsgas für die Glastrocknungsvorrichtung 1 ausgelegt. Ein Teil der wie vorangehend beschrieben konditionierten Umgebungsluft 8 wird als konditioniertes Spülgas 15 in die Beschichtungsvorrichtung 2 eingeleitet. Der Ventilator 17 unterstützt die Durchströmung der Beschichtungsvorrichtung 2 und das beladene Spülgas 16 wird zu einem Teil oder im Ganzen abgeführt oder zu einem Teil oder im Ganzen über eine Spülgasrückführung 18 erneut auf den Filter 9 geführt. Dabei kann wiederum Umgebungsluft 8 dem beladenen Spülgas 16 beigemischt werden.  
25  
30  
35

Während des Beschichtungsprozesses in der Beschichtungsvorrichtung 2 wird wiederum konditioniertes Spülgas 15 in die Druckschleusen geführt zum Druckausgleich in den Druckschleusen und/oder zum Spülen der Druckschleusen und des eventuell darin befindlichen Glassubstrats 3.

5

Die verbleibende konditionierte Umgebungsluft 8 wird als konditioniertes Trocknungsgas 5 in die Glastrocknungsvorrichtung 1 geführt. Das beladene Trocknungsgas 19 wird aus der Glastrocknungsvorrichtung 1 abgeführt und zu einem Teil oder im Ganzen an die Umgebungsluft abgegeben. Es ist aber auch  
10 möglich wie in FIG 3 dargestellt einen Teil oder den gesamten Volumenstrom des beladenen Trocknungsgases 19 in den Prozess zurückzuführen. Dabei kann beispielsweise ein Teil des beladenen Trocknungsgases 19 über eine Trocknungsgasrückführung 20 der bereits konditionierten Umgebungsluft 8 zugegeben werden und auf diese Weise das konditionierte Spülgas 15 erzeugt werden.  
15 Bevorzugt wird ist es jedoch, das beladene Trocknungsgas 19 über eine Trocknungsgasrückführung 21 in den Filter 9 zurückzuführen, wobei es mit der Umgebungsluft 8 und/oder dem beladenen Spülgas 16 gemischt werden kann.

FIG 4 zeigt eine vorteilhafte Ausführungsform einer mechanischen Impulsgebereinrichtung einer erfindungsgemäßen Vorrichtung zur Entfernung fester Verunreinigungen, sogenannter Depots 25, insbesondere von Beschichtungsmaterial, an Innenwänden 26 oder Einbauten 27 einer Prozesskammer 7. In FIG 4 ist schematisch eine Prozesskammer 7 im Schnitt dargestellt. An der Prozesskammerinnenwand 26 und an dem Einbau 27 befindet sich solch ein Depot  
20 25 an Beschichtungsmaterial. Zur Beseitigung des Depots 25 ist ein mechanischer Impulsgeber 23 vorgesehen, in diesem Fall eine Art Hammer, der an einer Führungsschiene 24 entlang der Prozesskammer 7 geführt werden kann (vgl. Pfeilrichtung entlang der Prozesskammer). Durch eine geeignete Führung ist es möglich den mechanischen Impulsgeber 23 sowohl in Längsrichtung als auch  
30 quer über die Prozesskammer 7, insbesondere deren Prozesskammeraußenwand 28, zu führen. Darüber hinaus kann sich der mechanische Impulsgeber 23 auch über die gesamte Länge der Prozesskammer 7 erstrecken, so dass er lediglich in eine Richtung quer zu seiner Längsausdehnung über die Prozesskammer 7, insbesondere deren Prozesskammeraußenwand 28, bewegt wird. Der mechanische  
35 Impulsgeber 23 kann in Pfeilrichtung senkrecht zu Prozesskammeraußenwand 28 bewegt werden, bis er auf die Prozesskammeraußenwand 28 auftrifft. Der

Impuls durch den Aufprall wird durch die Prozesskammeraußenwand 28 auf die Prozesskammerinnenwand 26 und/oder auf die Einbauten 27 und das darauf abgelagerte Depot 25 an Beschichtungsmaterial übertragen. Dadurch wird das Depot 25 wenigstens teilweise abgelöst und fällt durch Wirkung der Schwerkraft nach unten. Die Partikel können dann aus der Prozesskammer 7 herausgeführt werden.

**Bezugszeichenliste**

- |    |                               |
|----|-------------------------------|
| 1  | Glastrocknungsvorrichtung     |
| 2  | Beschichtungsvorrichtung      |
| 3  | Glassubstrat                  |
| 4  | Transportband                 |
| 5  | konditioniertes Trocknungsgas |
| 6  | Trocknungskammer              |
| 7  | Prozesskammer                 |
| 8  | Umgebungsluft                 |
| 9  | Filter                        |
| 10 | Fremdstoffe                   |
| 11 | Kältemaschine                 |
| 12 | Kondensat                     |
| 13 | Heizeinrichtung               |
| 14 | Verdichter                    |
| 15 | konditioniertes Spülgas       |
| 16 | beladenes Spülgas             |
| 17 | Ventilator                    |
| 18 | Spülgasrückführung            |
| 19 | beladenes Trocknungsgas       |
| 20 | Trocknungsgasrückführung      |
| 21 | Trocknungsgasrückführung      |
| 22 | Glaswaschvorrichtung          |
| 23 | mechanischer Impulsgeber      |
| 24 | Führungsschne                 |
| 25 | Depot                         |
| 26 | Prozesskammerinnenwand        |
| 27 | Einbau                        |
| 28 | Prozesskammeraußenwand        |

### Patentansprüche

1. Verfahren zum Reinigen wenigstens einer Prozesskammer (7) zum Beschichten wenigstens eines Substrats (3), insbesondere aus Glas,  
5 **dadurch gekennzeichnet,**  
dass die wenigstens eine Prozesskammer (7) vor einem Beschichtungsvorgang mit einem konditionierten Spülgas (15) gespült wird.
2. Verfahren nach Anspruch 1,  
10 bei dem die Feuchtigkeit des Spülgases vor dem Eintreten in die wenigstens eine Prozesskammer (7) auf einen vorgegebenen Feuchtigkeitswert eingestellt wird, insbesondere auf eine relative Feuchtigkeit von höchstens 30%, insbesondere höchstens 25%, vorzugsweise höchstens 10% oder sogar höchstens 5%.
3. Verfahren nach Anspruch 1 oder Anspruch 2,  
15 bei dem das Spülgas vor dem Eintreten in die wenigstens eine Prozesskammer (7) von Fremdstoffen gereinigt wird, insbesondere gefiltert wird.
4. Verfahren nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche,  
20 bei dem die Temperatur des Spülgases vor dem Eintreten in die wenigstens eine Prozesskammer (7) in wenigstens einem vorgegebenen Temperaturbereich, vorzugsweise auf wenigstens einen vorgegebenen Temperaturwert eingestellt wird, insbesondere in einem Temperaturbereich zwischen 20 °C und 90 °C, vorzugsweise in einem Temperaturbereich zwischen 60°C und 80°C.
5. Verfahren nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche,  
30 bei dem der Druck des Spülgases vor dem Eintreten in die wenigstens eine Prozesskammer (7) auf wenigstens einen vorgegebenen Druckwert eingestellt wird, vorzugsweise in einem Druckbereich zwischen 0,8 bar und 1,5 bar.
6. Verfahren nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche,  
35 bei dem als Spülgas Luft, insbesondere Umgebungsluft, und/oder ein Inertgas verwendet wird.



7. Verfahren nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche,  
bei dem während eines Reinigungsvorgangs die wenigstens eine Prozess-  
kammer (7) von dem konditionierten Spülgas (15) vorzugsweise kontinu-  
5 ierlich durchströmt wird, und/oder  
wenigstens ein Reinigungsschritt mit Fluten der Prozesskammer (7) mit  
konditioniertem Spülgas (15) und anschließendem Abführen des Spülga-  
ses (16) durchgeführt wird.
- 10 8. Verfahren, insbesondere nach einem oder mehreren der vorhergehenden  
Ansprüche,  
bei dem während eines bzw. des Reinigungsvorgangs eine an einem Ein-  
gang und/oder an einem Ausgang wenigstens einer Prozesskammer (7)  
zum Beschichten wenigstens eines Substrats (3), insbesondere aus Glas,  
15 angeordnete Druckschleuse mit konditioniertem Spülgas bzw. dem kon-  
ditionierten Spülgas (15) gespült wird.
9. Verfahren nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche,  
bei dem für einen Druckausgleich in der Druckschleuse konditioniertes  
20 Spülgas (15) in die Druckschleuse eingeströmt wird und/oder  
bei dem die Druckschleuse, bevor das wenigstens eine Substrat (3) in  
die Druckschleuse gelangt und/oder während sich das wenigstens eine  
Substrat (3) in der Druckschleuse befindet, mit konditioniertem Spülgas  
(15) gespült wird.  
25
10. Verfahren nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche,  
bei dem das Spülgas aus verschiedenen Gasströmen gemischt wird.
11. Verfahren nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche,  
30 bei dem das Spülgas in einem Kreislauf geführt wird.
12. Verfahren nach Anspruch 11,  
bei dem das aus der wenigstens einen Prozesskammer (7) austretende  
Spülgas (16) hinsichtlich der Feuchtigkeit und/oder der Beladung mit  
35 Fremdstoffen und/oder der Temperatur und/oder des Drucks und/oder  
der Gaszusammensetzung konditioniert wird.

13. Verfahren nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, bei dem das wenigstens eine Substrat (3) in einem dem Beschichtungsvorgang vorgeschalteten Substratbehandlungsvorgang vorbehandelt wird, insbesondere in einem Substrattrocknungsvorgang (1) mit vorgeschaltetem Substratwaschvorgang (22).
14. Verfahren nach Anspruch 13, bei dem wenigstens ein Teil eines konditionierten Trocknungsgases (5) zum Trocknen des wenigstens eines Substrats im Substrattrocknungsvorgang (1) und/oder wenigstens ein Teil eines aus dem Substrattrocknungsvorgang (1) ausgegebenen Trocknungsgases (19) zumindest zu einem Teil als konditioniertes Spülgas (15) verwendet wird.
15. Verfahren nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, bei dem die wenigstens eine Prozesskammer (7) vor und/oder während eines Reinigungsvorgangs zumindest teilweise beheizt wird, vorzugsweise von außen, insbesondere wenigstens ein Teil wenigstens einer Prozesskammerwand.
16. Verfahren nach Anspruch 15, bei dem die wenigstens eine Prozesskammer (7) zumindest teilweise auf eine Temperatur zwischen 20 °C und 60°C, insbesondere zwischen 40°C und 60°C, beheizt wird, insbesondere induktiv und/oder durch Strahlung und/oder durch Wärmeleitung.
17. Verfahren nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, bei dem wenigstens eine Impulsgebereinrichtung (23) vor und/oder während einem Beschichtungsvorgang wenigstens einen mechanischen Impuls auf eine Prozesskammerwand, insbesondere eine Außenwand (28), der wenigstens einen Prozesskammer (7) überträgt.
18. Verfahren nach Anspruch 17, bei dem als Impulsgebereinrichtung (23) wenigstens ein Hammer und/oder wenigstens eine Druckluftdüse und/oder wenigstens eine Vibrationseinheit und/oder wenigstens ein Ultraschallgeber verwendet wird.
19. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 17 bis 18,

bei dem der mechanische Impuls in Abhängigkeit wenigstens einer Prozessgröße automatisch ausgelöst wird und/oder die Stärke des mechanischen Impulses in Abhängigkeit eines Verschmutzungsgrads eingestellt wird.

5

20. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 17 bis 19, bei dem wenigstens ein Teil des aus der wenigstens einen Prozesskammer (7) austretenden Spülgases (16) zur Erzeugung des mechanischen Impulses verwendet wird.

10

21. Vorrichtung zum Reinigen wenigstens einer Prozesskammer (7) zum Beschichten wenigstens eines Substrats (3), insbesondere aus Glas, insbesondere zur Durchführung des Verfahrens nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche,

15

**dadurch gekennzeichnet,**

dass wenigstens eine Spüleinrichtung vorgesehen ist zur Einleitung eines konditionierten Spülgases (15) in die wenigstens eine Prozesskammer (7) und/oder zur Durchleitung eines konditionierten Spülgases (15) durch die wenigstens eine Prozesskammer (7) vor einem Beschichtungsvorgang.

20

22. Vorrichtung nach Anspruch 21, wobei die wenigstens eine Spüleinrichtung wenigstens eine Spülgaszuleitung und wenigstens eine Spülgasfördereinheit (14, 17) umfasst, insbesondere eine Pumpe und/oder einen Ventilator, die in einer Strömungsrichtung vor und oder nach der wenigstens einen Prozesskammer (7) angeordnet sind.

25

23. Vorrichtung nach Anspruch 21 oder Anspruch 22, wobei wenigstens eine Konditioniereinrichtung (9, 11, 13, 14) zur Konditionierung des Spülgases vor dem Eintreten in die Prozesskammer (7) vorgesehen ist.

30

24. Vorrichtung nach Anspruch 23, wobei wenigstens eine Konditioniereinrichtung (11) zur Einstellung einer Feuchtigkeit des Spülgases vorgesehen ist, insbesondere eine Adsorptionseinheit oder eine Kühleinheit, vorzugsweise eine Absorptions-

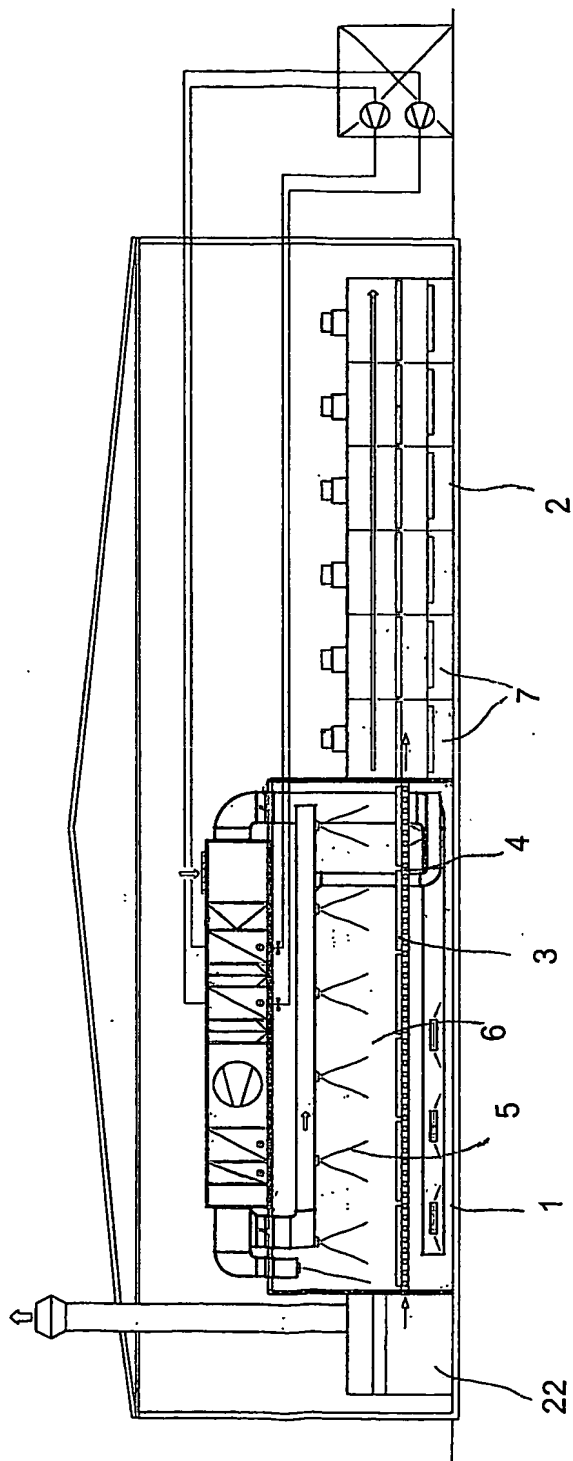
35

- kältemaschine, und/oder  
wobei wenigstens eine Konditioniereinrichtung (13) zur Einstellung einer Temperatur des Spülgases vorgesehen ist, insbesondere eine Heizeinrichtung, und/oder  
5 wobei wenigstens eine Konditioniereinrichtung (14) zur Einstellung eines Druckes des Spülgases vorgesehen ist, insbesondere ein Verdichter, und/oder  
wobei wenigstens eine Konditioniereinrichtung (9) zur Abscheidung von Fremdstoffen aus dem Spülgas vorgesehen ist, insbesondere eine Filtereinheit.  
10
25. Vorrichtung, insbesondere nach einem oder mehreren der Ansprüche 21 bis 24,  
wobei wenigstens eine Zuführeinrichtung vorgesehen ist zur Einleitung  
15 von konditioniertem Spülgas bzw. des konditionierten Spülgases (15) in wenigstens eine an einem Eingang einer Prozesskammer (7) zum Beschichten wenigstens eines Substrats (3), insbesondere aus Glas, und/oder an einem Ausgang einer Prozesskammer (7) zum Beschichten wenigstens eines Substrats (3), insbesondere aus Glas, angeordnete  
20 Druckschleuse und/oder zur Durchleitung von konditioniertem Spülgas bzw. des konditionierten Spülgases (15) durch die wenigstens eine Druckschleuse und/oder  
wobei wenigstens eine Abführeinrichtung für das Spülgas aus der wenigstens einen Druckschleuse vorgesehen ist.  
25
26. Vorrichtung nach einem oder mehreren der Ansprüche 21 bis 25,  
wobei wenigstens eine Heizeinrichtung vorgesehen ist zum Beheizen  
wenigstens eines Teils wenigstens einer Prozesskammer (7) vor  
und/oder während eines Reinigungsvorganges, die vorzugsweise außerhalb  
30 der Prozesskammer (7) angeordnet ist.
27. Vorrichtung nach einem oder mehreren der Ansprüche 21 bis 26,  
wobei wenigstens eine Impulsgebereinrichtung (23) vorgesehen ist, die  
vor einem Beschichtungsvorgang wenigstens einen mechanischen Impuls  
35 auf eine Prozesskammerwand, insbesondere eine Außenwand (28), der wenigstens einen Prozesskammer gibt.

28. Vorrichtung nach einem oder mehreren der Ansprüche 21 bis 27,  
wobei die wenigstens eine Impulsgebereinrichtung (23) wenigstens einen  
Hammer und/oder wenigstens eine Druckluftdüse und/oder wenigstens  
eine Vibrationseinheit und/oder wenigstens einen Ultraschallgeber  
5 und/oder wenigstens eine Steuereinheit umfasst.
29. Vorrichtung nach einem oder mehreren der Ansprüche 21 bis 28,  
wobei wenigstens ein Mittel vorgesehen ist zur Bestimmung von Pro-  
zessgrößen, insbesondere zur Erkennung eines Verschmutzungsgrades in  
10 der Prozesskammer.
30. Vorrichtung nach einem oder mehreren der Ansprüche 21 bis 29,  
wobei die wenigstens eine Konditioniereinrichtung (9, 11, 13, 14) we-  
nigstens eine Konditioniereinrichtung (9, 11, 13, 14) einer der wenig-  
15 stens einen Prozesskammer vorgeschalteten Substratbehandlungsvorrich-  
tung, insbesondere einer Substrattrocknungsvorrichtung (1) mit vorge-  
schalteter Substratwaschvorrichtung (22), ist.
31. Vorrichtung nach Anspruch 30,  
20 wobei wenigstens eine Einrichtung vorgesehen ist zur Einleitung we-  
nigstens eines Teils eines aus der Substrattrocknungsvorrichtung austre-  
tenden Trocknungsgases (19) und/oder wenigstens eines Teils eines in  
der wenigstens einen Konditioniereinrichtung aufbereiteten Trock-  
nungsgases (5) als wenigstens eines Teils des konditionierten Spülgases  
25 (15) in die Prozesskammer (7).
32. Verfahren zum Beschichten wenigstens eines Substrats, insbesondere  
aus Glas, in einer Prozesskammer,  
bei dem die Prozesskammer (7) vor einem Beschichtungsvorgang gerei-  
30 nigt wird mit einem Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprü-  
che 1 bis 18 und/oder unter Verwendung einer Vorrichtung nach einem  
oder mehreren der Ansprüche 19 bis 28.
33. Verfahren nach Anspruch 32,  
35 bei dem nach dem Reinigungsvorgang der Druck in der Prozesskammer  
(7) gegenüber dem Umgebungsdruck reduziert wird, vorzugsweise auf  
 $10^{-7}$  bar bis  $10^{-3}$  bar und anschließend ein Beschichtungsprozess gestartet

wird, insbesondere ein Beschichtungsprozess aus der Gasphase, vorzugsweise ein PVD- oder ein CVD-Prozess.

34. Vorrichtung zum Beschichten wenigstens eines Substrats, insbesondere  
5 aus Glas, in einer Prozesskammer (7), insbesondere zum Durchführen  
des Verfahrens nach Anspruch 29 oder Anspruch 30, umfassend  
eine separate Vorrichtung zur Reinigung der Prozesskammer (7) vor ei-  
nem Beschichtungsvorgang durch Spülen mit einem konditionierten  
Spülgas (15), insbesondere eine Vorrichtung nach einem oder mehreren  
10 der Ansprüche 19 bis 28.



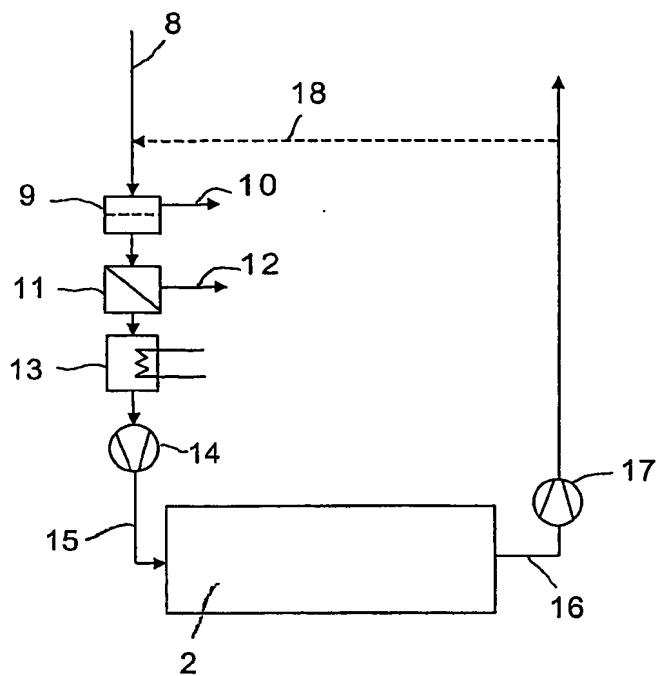


FIG 2

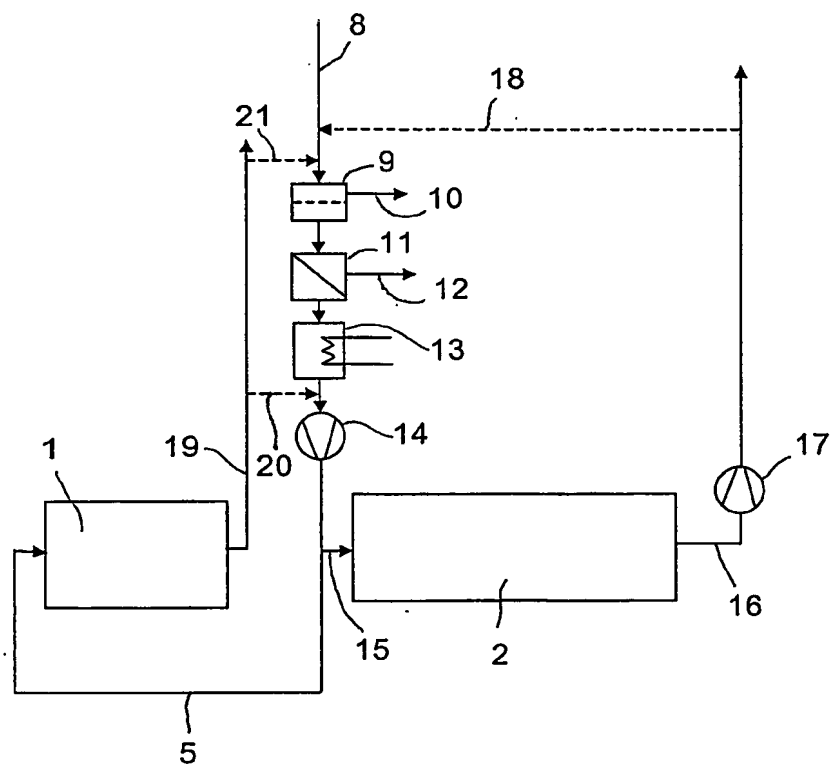


FIG 3



3/3

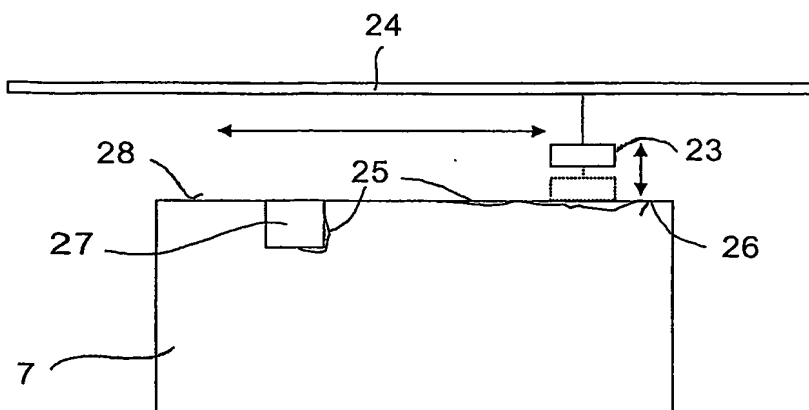


FIG 4

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No  
PCT/EP2004/000250

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER  
IPC 7 B08B7/00 C23C16/44 B01D24/00 H01L21/3213

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

## B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)  
IPC 7 B08B C23C B01D H01L

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal

## C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	US 6 596 091 B1 (GROSENBACHER TIM) 22 July 2003 (2003-07-22)  column 2, line 55 - column 3, line 59 column 4, line 36 - line 40 -----	1,4,6, 15, 21-26, 32-34
X	US 6 461 437 B1 (KUBOTA TAKESHI ET AL) 8 October 2002 (2002-10-08)  column 5, line 29 - line 59 column 6, line 59 - line 61 column 7, line 34 ----- -/-	1-3,5-8, 13, 21-25, 32-34

☒ Further documents are listed in the continuation of box C.

☒ Patent family members are listed in annex.

### \* Special categories of cited documents:

- \*A\* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- \*E\* earlier document but published on or after the international filing date
- \*L\* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- \*O\* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- \*P\* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- \*T\* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- \*X\* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- \*Y\* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.
- \*Z\* document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

7 September 2004

Date of mailing of the international search report

15/09/2004

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2  
NL - 2280 HV Rijswijk  
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Millitzer, E

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No  
PCT/EP2004/000250

## C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	US 2001/000759 A1 (AGGARWAL RAVINDER ET AL) 3 May 2001 (2001-05-03)  page 2, paragraph 11 - paragraph 13 page 3, paragraph 28 - paragraph 31	1,2,6-9, 12, 21-25, 32-34
X	US 5 378 283 A (USHIKAWA HARUNORI) 3 January 1995 (1995-01-03)  column 5, line 26 - column 6, line 3 figure 1	1,3,6-9, 11,12, 21-25, 32-34
X	US 5 924 447 A (EVANS BRYCE ET AL) 20 July 1999 (1999-07-20)  column 3, line 66 - column 6, line 8	1,3-6, 21-25, 32-34
X	US 2002/045966 A1 (KIM KWANG-SIG ET AL) 18 April 2002 (2002-04-18)  page 3, paragraph 30	1,3,7, 10, 21-24, 32,34
A	US 5 536 320 A (USHIKAWA HARUNORI ET AL) 16 July 1996 (1996-07-16)  column 3, line 3 - column 5, line 59	1-9, 11-15, 21-26, 30,32-34
A	US 5 391 275 A (MINTZ DONALD M) 21 February 1995 (1995-02-21) abstract	17-20, 27,28

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No  
PCT/EP2004/000250

Patent document cited in search report		Publication date		Patent family member(s)	Publication date
US 6596091	B1	22-07-2003	EP	1076729 A1	21-02-2001
			JP	2002513089 T	08-05-2002
			TW	411488 B	11-11-2000
			WO	9955931 A1	04-11-1999
US 6461437	B1	08-10-2002	JP	2001210693 A	03-08-2001
			CN	1307326 A	08-08-2001
US 2001000759	A1	03-05-2001	US	6161311 A	19-12-2000
			EP	1097251 A1	09-05-2001
			JP	2002520832 T	09-07-2002
			TW	445304 B	11-07-2001
			WO	0003056 A1	20-01-2000
US 5378283	A	03-01-1995	JP	3330166 B2	30-09-2002
			JP	6177066 A	24-06-1994
US 5924447	A	20-07-1999	US	5810031 A	22-09-1998
			CN	1164812 A	12-11-1997
			EP	0791670 A2	27-08-1997
			ID	16031 A	28-08-1997
			JP	10049236 A	20-02-1998
			SG	72748 A1	23-05-2000
			TW	406761 Y	21-09-2000
			US	6035609 A	14-03-2000
US 2002045966	A1	18-04-2002	KR	2002030905 A	26-04-2002
			JP	2002134490 A	10-05-2002
US 5536320	A	16-07-1996	JP	3120395 B2	25-12-2000
			JP	6267933 A	22-09-1994
US 5391275	A	21-02-1995	US	5202008 A	13-04-1993
			DE	69305291 D1	14-11-1996
			DE	69305291 T2	28-05-1997
			EP	0584483 A1	02-03-1994
			ES	2094968 T3	01-02-1997
			JP	3133196 B2	05-02-2001
			JP	6192859 A	12-07-1994
			KR	272111 B1	15-11-2000
			DE	69111490 D1	31-08-1995
			DE	69111490 T2	18-04-1996
			EP	0446657 A1	18-09-1991
			ES	2076385 T3	01-11-1995
			JP	2109550 C	21-11-1996
			JP	5106020 A	27-04-1993
			JP	8019515 B	28-02-1996
			KR	226809 B1	15-10-1999

# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen  
PCT/EP2004/000250

<b>A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES</b> IPK 7 B08B7/00 C23C16/44 B01D24/00 H01L21/3213		
Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK		
<b>B. RESEARCHIERTE GEBIETE</b> Recherchierte Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole) IPK 7 B08B C23C B01D H01L		
Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen		
Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe) EPO-Internal		
<b>C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN</b>		
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	US 6 596 091 B1 (GROSENBACHER TIM) 22. Juli 2003 (2003-07-22)  Spalte 2, Zeile 55 - Spalte 3, Zeile 59 Spalte 4, Zeile 36 - Zeile 40	1, 4, 6, 15, 21-26, 32-34
X	US 6 461 437 B1 (KUBOTA TAKESHI ET AL) 8. Oktober 2002 (2002-10-08)  Spalte 5, Zeile 29 - Zeile 59 Spalte 6, Zeile 59 - Zeile 61 Spalte 7, Zeile 34	1-3, 5-8, 13, 21-25, 32-34
-/--		
<input checked="" type="checkbox"/> Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen <input checked="" type="checkbox"/> Siehe Anhang Patentfamilie		
* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen : *A* Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist *E* älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist *L* Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt) *O* Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht *P* Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist *T* Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist *X* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden *Y* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist *&* Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist		
Datum des Abschlusses der internationalen Recherche 7. September 2004		Absenddatum des internationalen Recherchenberichts 15/09/2004
Name und Postanschrift der internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2260 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016		Bevollmächtigter Bediensteter Millitzer, E

## INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2004/000250

C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	US 2001/000759 A1 (AGGARWAL RAVINDER ET AL) 3. Mai 2001 (2001-05-03)  Seite 2, Absatz 11 - Absatz 13 Seite 3, Absatz 28 - Absatz 31	1,2,6-9, 12, 21-25, 32-34
X	US 5 378 283 A (USHIKAWA HARUNORI) 3. Januar 1995 (1995-01-03)  Spalte 5, Zeile 26 - Spalte 6, Zeile 3 Abbildung 1	1,3,6-9, 11,12, 21-25, 32-34
X	US 5 924 447 A (EVANS BRYCE ET AL) 20. Juli 1999 (1999-07-20)  Spalte 3, Zeile 66 - Spalte 6, Zeile 8	1,3-6, 21-25, 32-34
X	US 2002/045966 A1 (KIM KWANG-SIG ET AL) 18. April 2002 (2002-04-18)  Seite 3, Absatz 30	1,3,7, 10, 21-24, 32,34
A	US 5 536 320 A (USHIKAWA HARUNORI ET AL) 16. Juli 1996 (1996-07-16)  Spalte 3, Zeile 3 - Spalte 5, Zeile 59	1-9, 11-15, 21-26, 30,32-34
A	US 5 391 275 A (MINTZ DONALD M) 21. Februar 1995 (1995-02-21) Zusammenfassung	17-20, 27,28

# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2004/000250

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
US 6596091 B1	22-07-2003	EP 1076729 A1 JP 2002513089 T TW 411488 B WO 9955931 A1	21-02-2001 08-05-2002 11-11-2000 04-11-1999
US 6461437 B1	08-10-2002	JP 2001210693 A CN 1307326 A	03-08-2001 08-08-2001
US 2001000759 A1	03-05-2001	US 6161311 A EP 1097251 A1 JP 2002520832 T TW 445304 B WO 0003056 A1	19-12-2000 09-05-2001 09-07-2002 11-07-2001 20-01-2000
US 5378283 A	03-01-1995	JP 3330166 B2 JP 6177066 A	30-09-2002 24-06-1994
US 5924447 A	20-07-1999	US 5810031 A CN 1164812 A EP 0791670 A2 ID 16031 A JP 10049236 A SG 72748 A1 TW 406761 Y US 6035609 A	22-09-1998 12-11-1997 27-08-1997 28-08-1997 20-02-1998 23-05-2000 21-09-2000 14-03-2000
US 2002045966 A1	18-04-2002	KR 2002030905 A JP 2002134490 A	26-04-2002 10-05-2002
US 5536320 A	16-07-1996	JP 3120395 B2 JP 6267933 A	25-12-2000 22-09-1994
US 5391275 A	21-02-1995	US 5202008 A DE 69305291 D1 DE 69305291 T2 EP 0584483 A1 ES 2094968 T3 JP 3133196 B2 JP 6192859 A KR 272111 B1 DE 69111490 D1 DE 69111490 T2 EP 0446657 A1 ES 2076385 T3 JP 2109550 C JP 5106020 A JP 8019515 B KR 226809 B1	13-04-1993 14-11-1996 28-05-1997 02-03-1994 01-02-1997 05-02-2001 12-07-1994 15-11-2000 31-08-1995 18-04-1996 18-09-1991 01-11-1995 21-11-1996 27-04-1993 28-02-1996 15-10-1999